

第一章 非线性电阻电路

1.1 非线性电阻电路的基本分析方法

1.1.1 图解法

图解法是相对较为直观的方法，它不能求出精确的解，但是可以分析大致的特征。对于含有非线性电阻的电路，可以将其拆分为两个对接的网络，一方是线性网络，一方是非线性网络，并且用关联参考方向、源关联参考方向定义两个网络。作出两个网络的伏安特性曲线，其交点就是所求的解。这个解是粗略的，下面的方法更能求得精确的或者接近精确值的解。

1.1.2 牛顿-拉夫逊迭代法

在上面图解法的基础上，牛顿-拉夫逊迭代法可以求得尽可能精确的解。联立曲线方程，得到一个方程 $f(x) = 0$ 。这个方程是超越的，那么可以用迭代法。给定一个大致的解 $x^{(0)}$ ，每一次迭代(这里是 $k+1$ 次)都对上一次解进行一个修正 $\Delta x^{(k)}$ ，也就是 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$ 。由Taylor展开可以得到

$$\begin{aligned}f(x^{(k+1)}) &= f(x^{(k)} + \Delta x^{(k)}) \approx f(x^{(k)}) + f'(x^{(k)})\Delta x^{(k)} = 0 \\ \Delta x^{(k)} &= -\frac{f(x^{(k)})}{f'(x^{(k)})} \\ x^{(k+1)} &= x^{(k)} - \frac{f(x^{(k)})}{f'(x^{(k)})}\end{aligned}$$

设定一个精确度 ε ，如果 $f(x^{(k)}) < \varepsilon$ ，就认为精度足够了，迭代终止。一般而言，不到十次就可以得到比较精确的解。这种方法适用于计算机分析，手工分析更常用后面的方法。

1.1.3 分段折线法

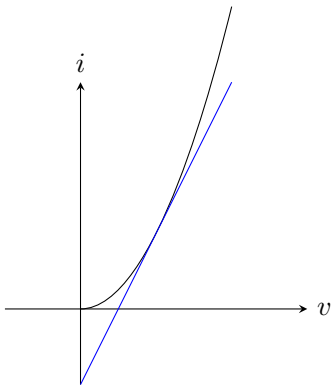
分段折线法是一种化曲为直的方法。如果伏安特性曲线有明显的分区特性，就可以用直线代替曲线，从而手工解出较为准确的解。对于曲线的一部分，可以利用割线或者切线来代替曲线。有时不知道位于哪个工作区时，可以先假设位于其中某个区，然后计算验证，如果符合，则假设成立；如果不符合，应该另外设别的区。分段折线法更多地会结合下面的方法运用。

1.1.4 局部线性法

局部线性法适用于直流与交流叠加的电压： $v = V_0 + \Delta v$ ，习惯用大写字母表示直流量，小写字母表示交流量。对于含有此类电信号的非线性电路，采取的方法是将直流和交流分别分析：首先只看直流，利用前面提到的方法确定直流工作点(区)；然后只看交流，确定更细致的关系。对于电源、电阻、电容、电感元件，在直流情形和交流情形的分析如下：

(1)电源：将电源分为恒压源和交流电压源，在直流情形下，将交流电压源短路即可；在交流情形下，将恒压源短路即可。

(2)电阻：对于线性电阻，直流情形和交流情形的分析相同；对于非线性电阻，其伏安特性曲线并非直线，在直流情形下按照前面的方法分析，在交流情形下视为电阻，其阻值是伏安特性曲线在直流工作点切线斜率的倒数，这个电阻称为微分电阻。



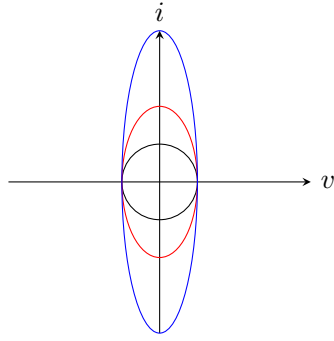
(3)电容电感：以电容为例，其电压电流特性为

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

我们设 $v(t) = V_0 + V_m \cos \omega t$ ，则可以得到 $i(t) = -\omega C V_m \sin \omega t$ ，因而

$$\frac{(v(t) - V_0)^2}{V_m^2} + \frac{i(t)^2}{\omega^2 C^2 V_m^2} = 1$$

当 $V_0 = 0$ 时，其图像是以原点为中心的椭圆，长半轴为 $\omega C V_m$ ，短半轴为 V_m 。对于高频交流电压，其长半轴将是无限长，此时近似为经过原点且垂直于 v 轴的直线，也就是短路。而当 $\omega = 0$ 时，则相当于开路。当 $V_0 \neq 0$ 时，则抽象为恒压源。



同理，对于电感元件，当初始电流为0时，对于高频交流电压相当于开路，对于直流电压则相当于短路。

综合上述几方面，我们可以得到直流与交流分析时的元件处理办法。

元件	直流分析	交流分析
直流源	不变	屏蔽
交流源	屏蔽	不变
电阻	不变	微分电阻替代
耦合电容	开路	短路
高频扼流圈	短路	开路

考虑单端口线性网络(L)与非线性网络(N)的对接，假设非线性网络的GOL为 $v = f(i)$ ，则有

$$v_{TH} - Ri = f(i)$$

现在假设电源电压是波动的，我们有 $v_{TH} = V_{TH} + \Delta v$ ， $i = I_0 + \Delta i$ ，则上述方程可以拆解为

$$\begin{aligned} V_{TH} - RI_0 &= f(I_0) \\ \Delta v - r\Delta i &= f'(I_0)\Delta i \end{aligned}$$

如果网络 L 是阻性的, 则 $R = r$; 如果含有耦合电容或高频扼流圈, 则会出现 $R \neq r$, 需要分别处理。

现在考虑二端口网络。假设有两个二端口网络连接在一起, 则需要从四种连接方式中选取较为合适的。以 z 参量为例, 对于线性网络, 我们有

$$\begin{pmatrix} v_{L1} \\ v_{L2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{L1} \\ i_{L2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_{TH1} \\ v_{TH2} \end{pmatrix}$$

对于非线性网络, 我们有

$$\begin{pmatrix} v_{N1} \\ v_{N2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(i_{N1}, i_{N2}) \\ f_2(i_{N1}, i_{N2}) \end{pmatrix}$$

两个网络串串连接, 之后两个端口短路处理(电路是闭合的), 那么我们可以得到

$$\begin{pmatrix} f_1(i_1, i_2) \\ f_2(i_1, i_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_{TH1} \\ v_{TH2} \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

假设现在电压源有波动, 电流也有相应波动。我们可以得到

$$\begin{aligned} f_1(I_{10} + \Delta i_1, I_{20} + \Delta i_2) &= f_1(I_{10}, I_{20}) + \frac{\partial f_1}{\partial i_1} \Delta i_1 + \frac{\partial f_1}{\partial i_2} \Delta i_2 \\ f_2(I_{10} + \Delta i_1, I_{20} + \Delta i_2) &= f_2(I_{10}, I_{20}) + \frac{\partial f_2}{\partial i_1} \Delta i_1 + \frac{\partial f_2}{\partial i_2} \Delta i_2 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{pmatrix} f_1(I_{10} + \Delta i_1, I_{20} + \Delta i_2) \\ f_2(I_{10} + \Delta i_1, I_{20} + \Delta i_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(I_{10}, I_{20}) \\ f_2(I_{10}, I_{20}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \partial_1 f_1 & \partial_2 f_1 \\ \partial_1 f_2 & \partial_2 f_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta i_1 \\ \Delta i_2 \end{pmatrix}$$

由此, 就可以将其拆分为如下两个方程

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} f_1(I_{10}, I_{20}) \\ f_2(I_{10}, I_{20}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{10} \\ I_{20} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_{TH10} \\ V_{TH20} \end{pmatrix} &= \mathbf{0} \\ \begin{pmatrix} \partial_1 f_1 & \partial_2 f_1 \\ \partial_1 f_2 & \partial_2 f_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta i_1 \\ \Delta i_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta i_1 \\ \Delta i_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta v_{TH1} \\ \Delta v_{TH2} \end{pmatrix} &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

其中 Z 和 z 的区别同样在于耦合电容和高频扼流圈。综上, 局部线性法的要点在于:

(1)直流分析: 忽略交流部分, 画出直流情形下的电路, 通过解析法、分段折线法等求得直流工作点。

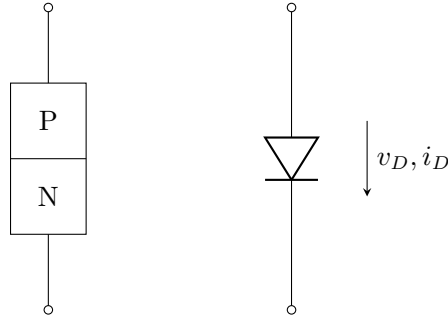
(2)交流分析：忽略直流部分，画出交流情形下的电路，进行进一步的分析。

其实，第一步的操作相当于坐标轴的平移，以直流工作点作为新的原点，建立新的坐标轴，进行分析。

1.2 二极管及其应用

1.2.1 二极管的特性

这里我们介绍PN结二极管，涉及普通二极管与Zener二极管。按照关联参考方向定义，从P指向N，如图所示



PN结二极管有一个势垒电压，取0.7V。当 $v_D < 0.7V$ 时，此时的电流极其微小，只有fA 量级，降低电压不会引起电流的明显变化，达到**电流饱和**，一般取饱和电流 $I_{S0} = 1fA$ 。当 $v_D > 0.7V$ 时， i_D 满足

$$i_D = I_{S0}(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1)$$

其中

$$v_T = \frac{kT}{q} \approx 26mV \quad (298K)$$

k 是玻尔兹曼常数， T 是温度， q 是电荷量，这里是电子的电量。在室温($25^\circ C \approx 298K$) 下取值为26mV。

一般二极管应该避免被击穿，而Zener二极管则专门设计工作在反向击穿区。反向击穿区有三个重要的工作点:(1)拐点电流 I_{ZK} ，反偏电流大于这个值才会进入击穿区;(2)测试电流 I_{ZT} ，相对应测出电压 V_Z ， $V_Z @ I_{ZT}$;(3)最大电流 I_{ZM} ，二极管电流不应该超过这个值，否则有可能损毁二极管。

1.2.2 二极管的模型

1.2.3 二极管的应用

1.3 MOSFET及其应用

1.4 BJT及其应用